

2SA594

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ(PCT方式)

通信工業用

単位：mm

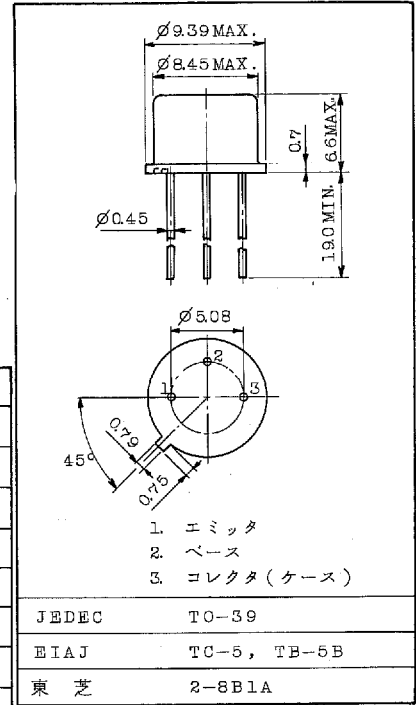
- 高周波増幅用
- 映像増幅用
- 高速度スイッチング用

特長

- ・ トランジション周波数が高い。： $f_T = 200\text{MHz}$ (標準)
- ・ コレクタ出力容量が小さい。： $C_{ob} = 3.5\text{pF}$ (標準)
- ・ 2SC594とコンプリメンタリになります。

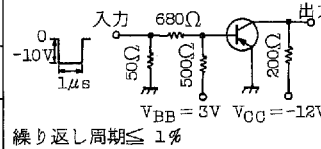
最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-45	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-200	mA
ベース電流	I_B	-50	mA
コレクタ損失	PC	Ta=25°C	750 mW
		Tc=25°C	5 W
接合温度	T_j	175	°C
保存温度	T_{stg}	-65~175	°C



電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CE} = -45\text{V}, I_B = 0$	-	-	-0.1	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	-	-	-0.1	μA
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -1\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	40	-	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -3\text{V}, I_C = -200\text{mA}$	20	-	-	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -10\text{mA}$	-	-	-0.3	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -10\text{mA}$	-	-	-1.0	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = -10\text{V}, I_C = -10\text{mA}$	100	200	-	MHz
入力インピーダンス(実数部)	$Re(h_{ie})$	$V_{CE} = -10\text{V}, I_F = 10\text{mA}, f = 200\text{MHz}$	-	-	120	Ω
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CE} = -10\text{V}, I_B = 0, f = 1\text{MHz}$	-	3.5	.5	pF
スイッチング時間	ターンオン時間	t_{on}	-	40	-	ns
	蓄積時間	t_{stg}	-	250	-	
	下降時間	t_f	-	30	-	



注： $h_{FE(1)}$ 分類 R：40~80，O：70~140，Y：120~240

